1. p-n переход изготовлен на основе Si. $ N \_{A }=10^{15 }см^{-3 }$, $N\_{Д}=10^{15} см^{-3}, $ ∆$W\_{A}=0.03 эВ$

∆$W\_{Д}=0.04 эВ$, Т=310 К, ∆W=1.1 эВ, $N\_{c}=N\_{v}=5∙10^{19}см^{-3}$

Определить концентрацию основных и неосновных носителей заряда в n области p-n перехода.